a 2018 0065

Изобретение относится к способам получения полупроводниковых материалов и может быть использовано в полупроводниковой технологии.
Способ, согласно изобретению, состоит в спекании порошков ZnO методом химической транспортной реакции в закрытом объеме при температуре спекания 900…1150°C, в течение 48...72 часов, с градиентом температуры в области спекания ≤10°C/cm и скоростью охлаждения полученной керамики ≤100°C/час. В качестве транспортных агентов используют HCl с начальным давлением 1…6 атм., H_2 с начальным давлением 50…200% от начального давления HCl и C в количестве ≤HCl (моль).

П. формулы: 1
Фиг.: 3